

	<p><b>GP2M008A060HG</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> GP2M008A060HG</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Global Power Technologies Group</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">GP2M008A060HG.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>


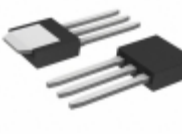

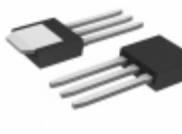



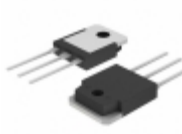
Spezifikationen

Teilenummer	GP2M008A060HG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3.75A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1063pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Tc)

GP2M008A060HG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M008A060HG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M008A060HG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ GP2M008A060HG E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>GP2M010A060F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220F</p>	 <p><b>GP2M008A060PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A IPAK</p>	 <p><b>GP2M008A060FGH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220F</p>	 <p><b>GP2M008A060PGH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A IPAK</p>
 <p><b>GP2M007A080F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 7A TO220F</p>	 <p><b>GP2M007A065HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 6.5A TO220</p>	 <p><b>GP2M008A060CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A DPAK</p>	 <p><b>GP2M009A090NG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9A TO3PN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP2M008A060HG Global Power Technologies Group	GP2M008A060HG Datenblatt	GP2M008A060HG-Datenblätter	GP2M008A060HG PDF	Global Power Technologies Group GP2M008A060HG
GP2M008A060HG Electronic	GP2M008A060HG-Komponenten	GP2M008A060HG-Verteiler	GP2M008A060HG-Bild	GP2M008A060HG-Teil
GP2M008A060HG Preis	GP2M008A060HG Hersteller	GP2M008A060HG Bild	GP2M008A060HG Aktie	GP2M008A060HG Inventar
GP2M008A060HG Neu	GP2M008A060HG Original	GP2M008A060HG garantiert	GP2M008A060HG RFQ	GP2M008A060HG Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited